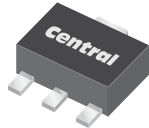


CXTA42 NPN  
CXTA92 PNP

**SURFACE MOUNT  
COMPLEMENTARY  
HIGH VOLTAGE  
SILICON TRANSISTORS**



**SOT-89 CASE**



[www.centrasemi.com](http://www.centrasemi.com)

**DESCRIPTION:**

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CXTA42, CXTA92 types are complementary surface mount epoxy molded silicon planar epitaxial transistors designed for high voltage applications.

**MARKING: FULL PART NUMBER**

**MAXIMUM RATINGS:** ( $T_A=25^\circ\text{C}$ )

	<b>SYMBOL</b>	<b>CXTA42</b>	<b>CXTA92</b>	<b>UNITS</b>
Collector-Base Voltage	$V_{CBO}$	300	300	V
Collector-Emitter Voltage	$V_{CEO}$	300	300	V
Emitter-Base Voltage	$V_{EBO}$	6.0	5.0	V
Continuous Collector Current	$I_C$		500	mA
Power Dissipation	$P_D$		1.2	W
Operating and Storage Junction Temperature	$T_J, T_{stg}$		-65 to +150	$^\circ\text{C}$
Thermal Resistance	$\theta_{JA}$		104	$^\circ\text{C/W}$

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS:** ( $T_A=25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted)

<b>SYMBOL</b>	<b>TEST CONDITIONS</b>	<b>CXTA42</b>		<b>CXTA92</b>		<b>UNITS</b>
		<b>MIN</b>	<b>MAX</b>	<b>MIN</b>	<b>MAX</b>	
$I_{CBO}$	$V_{CB}=200\text{V}$	-	100	-	250	nA
$I_{EBO}$	$V_{BE}=6.0\text{V}$	-	100	-	-	nA
$I_{EBO}$	$V_{BE}=3.0\text{V}$	-	-	-	100	nA
$BV_{CBO}$	$I_C=100\mu\text{A}$	300	-	300	-	V
$BV_{CEO}$	$I_C=1.0\text{mA}$	300	-	300	-	V
$BV_{EBO}$	$I_E=100\mu\text{A}$	6.0	-	5.0	-	V
$V_{CE(SAT)}$	$I_C=20\text{mA}, I_B=2.0\text{mA}$	-	0.5	-	0.5	V
$V_{BE(SAT)}$	$I_C=20\text{mA}, I_B=2.0\text{mA}$	-	0.9	-	0.9	V
$h_{FE}$	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=1.0\text{mA}$	25	-	25	-	
$h_{FE}$	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=10\text{mA}$	40	-	40	-	
$h_{FE}$	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=30\text{mA}$	40	-	25	-	
$f_T$	$V_{CE}=20\text{V}, I_C=10\text{mA}, f=100\text{MHz}$	50	-	50	-	MHz
$C_{ob}$	$V_{CB}=20\text{V}, I_E=0, f=1.0\text{MHz}$	-	3.0	-	6.0	pF

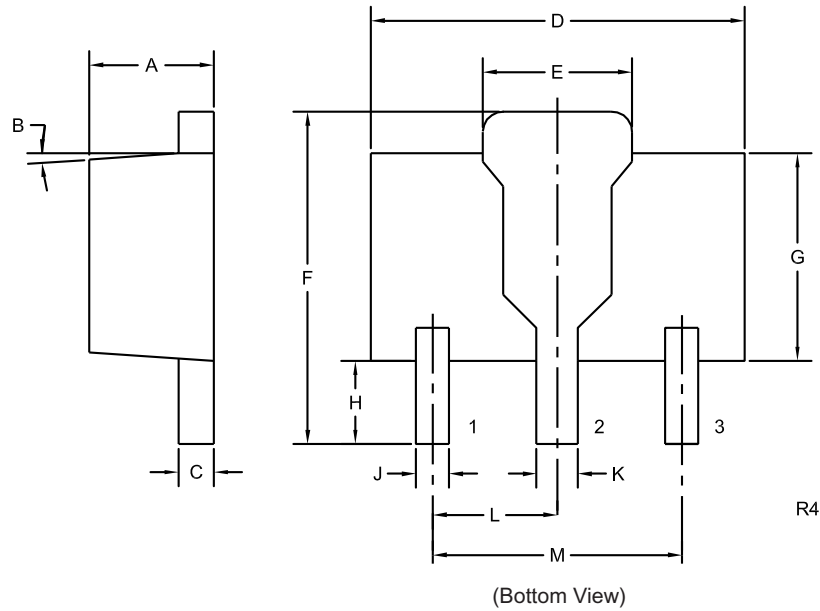
R7 (23-May 2011)

CXTA42 NPN  
 CXTA92 PNP

SURFACE MOUNT  
 COMPLEMENTARY  
 HIGH VOLTAGE  
 SILICON TRANSISTORS



SOT-89 CASE - MECHANICAL OUTLINE



LEAD CODE:

- 1) Emitter
- 2) Collector
- 3) Base

MARKING:  
 FULL PART NUMBER

SYMBOL	DIMENSIONS			
	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.055	0.067	1.40	1.70
B	4°		4°	
C	0.014	0.018	0.35	0.46
D	0.173	0.185	4.40	4.70
E	0.064	0.074	1.62	1.87
F	0.146	0.177	3.70	4.50
G	0.090	0.106	2.29	2.70
H	0.028	0.051	0.70	1.30
J	0.014	0.019	0.36	0.48
K	0.017	0.023	0.44	0.58
L	0.059		1.50	
M	0.118		3.00	

SOT-89 (REV: R4)

R7 (23-May 2011)

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9